

DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for use as R.F., I.F. and A.F. amplifier

DIODE-PENTHODE à pente variable pour l'utilisation en amplificatrice H.F., M.F. et B.F.

DIODE-PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als H.F.-, Z.F.- und N.F.- Verstärker

Heating : indirect by A.C. or D.C.;  
parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;  
alimentation en parallèle

Heizung : indirekt durch Wechsel-  
oder Gleichstrom; Parallel-  
speisung

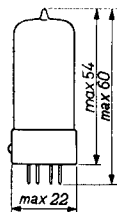
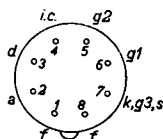
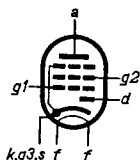
$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 0,2 \text{ A}$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Rimlock

Capacitances  
Capacités  
Kapazitäten

Pentode section  
Partie penthode  
Pentodenteil

Diode section  
Partie diode  
Diodenteil

$C_a = 6,5 \text{ pF}$

$C_d = 3,8 \text{ pF}$

$C_{g1} = 4,0 \text{ pF}$

$C_{df} < 0,02 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,002 \text{ pF}$

$C_{g1f} < 0,05 \text{ pF}$

Between diode and pentode sections  
Entre les parties diode et penthode  
Zwischen Dioden- und Pentodenteil

$C_{dg1} < 0,0015 \text{ pF}$

$C_{da} < 0,15 \text{ pF}$

Operating characteristics of the pentode section as R.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode en amplificatrice H.F. ou M.F.

Betriebsdaten des Pentodenteiles als H.F.-oder Z.F.-Verstärker

|              |   |                                        |                   |
|--------------|---|----------------------------------------|-------------------|
| $V_a$        | = | 250                                    | V                 |
| $R_{g2}$     | = | 95                                     | k $\Omega$        |
| $R_k$        | = | 300                                    | $\Omega$          |
| $V_{g1}$     | = | $\overbrace{-2 \quad \quad \quad -40}$ | V                 |
| $I_a$        | = | 5                                      | mA                |
| $I_{g2}$     | = | 1,6                                    | mA                |
| S            | = | 1800                                   | $\mu A/V$         |
| $R_i$        | = | 1,2                                    | $> 10$ M $\Omega$ |
| $\mu_{g2g1}$ | = | 19                                     | -                 |
| $R_{eq}$     | = | 9,0                                    | k $\Omega$        |

Limiting values of the pentode section

Caractéristiques limites de la partie penthode

Grenzdaten des Pentodenteiles

|                                 |        |               |
|---------------------------------|--------|---------------|
| $V_{ao}$                        | = max. | 550 V         |
| $V_a$                           | = max. | 300 V         |
| $W_a$                           | = max. | 2 W           |
| $V_{g2o}$                       | = max. | 550 V         |
| $V_{g2} (I_a < 2,5 \text{ mA})$ | = max. | 300 V         |
| $V_{g2} (I_a = 5 \text{ mA})$   | = max. | 125 V         |
| $W_{g2}$                        | = max. | 0,3 W         |
| $I_k$                           | = max. | 10 mA         |
| $V_{g1} (I_{g1} = +0,3 \mu A)$  | = max. | -1,3 V        |
| $R_{g1}$                        | = max. | 3 M $\Omega$  |
| $R_{kf}$                        | = max. | 20 k $\Omega$ |
| $V_{kf}$                        | = max. | 50 V          |

Limiting values of the diode section

Caractéristiques limites de la partie diode

Grenzdaten des Diodenteiles

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| $V_d \text{ invp}$ | = max. | 350 V  |
| $I_d$              | = max. | 0,8 mA |
| $I_{dp}$           | = max. | 5 mA   |



|      | EAF41 |            |
|------|-------|------------|
| page | sheet | date       |
| 1    | 1     | 1953.04.04 |
| 2    | 2     | 1953.04.04 |
| 3    | FP    | 1999.06.12 |